

Содержание

● Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Хомец А.Л., Сафронов И.В., Филонов А.Б., Мигас Д.Б.

Влияние морфологии поверхности и границ раздела на продольную фононную теплопроводность в тонкопленочных структурах Ge(001) и Si/Ge(001) 131

Суханов М.А., Бакаров А.К., Журавлев К.С.

Процесс десорбции оксида с поверхности InSb в потоке сурьмы 138

Алмаев Д.А., Алмаев А.В., Николаев В.И., Бутенко П.Н., Щеглов М.П., Чикиряка А.В., Печников А.И.

Высокая чувствительность пленок оксида индия, полученных методом хлоридной газовой фазной эпитаксии, к аммиаку 145

Чернов М.Ю., Соловьев В.А., Иванов С.В.

Снижение плотности дислокаций в метаморфных гетероструктурах путем оптимизации конструкции буферного слоя с нелинейным профилем изменением состава 153

● Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Котова Л.В., Белова Д.Д., Andre R., Mariette H., Кочерешко В.П.

Легкие и тяжелые экситоны в напряженных квантовых ямах CdTe/CdZnTe 160

Резник А.Н., Востоков Н.В.

Микроволновая вольт-импедансная спектроскопия полупроводниковой структуры 169

Быков А.А., Номоконов Д.В., Горан А.В., Стрыгин И.С., Марчишин И.В., Бакаров А.К.

Влияние подсветки на квантовое время жизни в селективно-легированных одиночных GaAs квантовых ямах с короткопериодными AlAs/GaAs-сверхрешеточными барьерами 181

Денисов К.С., Голеницкий К.Ю.

Эффективная генерация спина в графене на магнитной подложке при поглощении света в дальнем ИК диапазоне 187

● Физика полупроводниковых приборов

Полушкин Е.А., Нефедьев С.В., Солтанович О.А., Ковальчук А.В., Шаповал С.Ю.

Повышение радиационной стойкости интегральных схем на основе биполярных транзисторов обработкой в водородной электронно-циклотронно-резонансной плазме и геттерированием Si-пластин 195

Крыжановская Н.В., Блохин С.А., Махов И.С., Моисеев Э.И., Надточий А.М., Фоминых Н.А., Минтаилов С.А., Калюжный Н.А., Гусева Ю.А., Кулагина М.М., Зубов Ф.И., Колодезный Е.С., Максимов М.В., Жуков А.Е.

Исследование $p-i-n$ -фотодетектора с поглощающей средой на основе InGaAs/GaAs квантовых яма-точек 202

Дашков А.С., Костромин Н.А., Бабищев А.В., Горай Л.И., Егоров А.Ю.

Моделирование зонной структуры сверхрешеток на основе „разбавленных“ нитридов 207

Жуков А.Е., Крыжановская Н.В., Махов И.С., Моисеев Е.И., Надточий А.М., Фоминых Н.А., Минтаилов С.А., Калюжный Н.А., Зубов Ф.И., Максимов М.В.

Модель быстрого действия волноводного фотодиода с квантовыми точками 215

Volcheck V., Lovshenko I., Stempitsky V.

Design optimization of the gallium nitride high electron mobility transistor with graphene and boron nitride heat-spreading elements 221

● Персоналии

Памяти Леонида Евгеньевича Воробьева 222